



2SB624 (3CG624)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于音频放大。

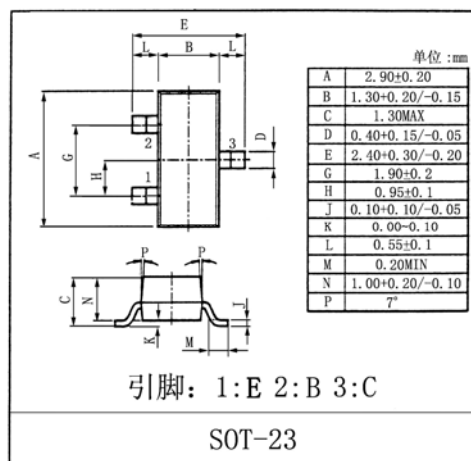
Purpose: Audio frequency amplifier application .

特点:高 h_{FE} , 与 2SD596 (3DG596M) 互补。

Features: High h_{FE} , complementary pair with 2SD596 (3DG596M).

极限参数/Absolute Maximum Ratings($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	-30	V
V_{CE0}	-25	V
V_{EB0}	-5.0	V
I_C	-700	mA
P_C	200	mW
T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$



电性能参数/Electrical Characteristics($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test Condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
I_{CB0}	$V_{CB}=-30\text{V}$ $I_E=0$			-0.1	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=-5.0\text{V}$ $I_C=0$			-0.1	μA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-1.0\text{V}$ $I_C=-100\text{mA}$	110	200	400	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-1.0\text{V}$ $I_C=-700\text{mA}$	50			
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-700\text{mA}$ $I_B=-70\text{mA}$		-0.25	-0.6	V
V_{BE}	$V_{CE}=-6.0\text{V}$ $I_C=-10\text{mA}$	-0.6	-0.64	-0.7	V
f_T	$V_{CE}=-6.0\text{V}$ $I_E=10\text{mA}$		160		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-6.0\text{V}$ $I_E=0$ $f=10\text{MHz}$		17		pF

$h_{FE(1)}$ 分档、印章/ $h_{FE(1)}$ Classifications、Marking:

$h_{FE(1)}$ 分档 $h_{FE(1)}$ Classifications	1	2	3	4	5
$h_{FE(1)}$ 范围 $h_{FE(1)}$ Range	110~180	135~220	170~270	200~320	250~400
印章 Marking	HBV1	HBV2	HBV3	HBV4	HBV5

